

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### о переносе даты заседания экспертной комиссии

В связи с принятием дополнительных мер по организации заседаний экспертных комиссий в период реализации мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, во исполнение приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14.03.2020 г. № 398 «О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» по решению Диссертационного совета НИТУ «МИСиС» от 10.06.2020 (протокол № 19) заседание экспертной комиссии по защите кандидатской диссертационной работы **Зиновьева Романа Александровича** «Исследование дефектов в GaN светодиодах» (специальность 01.04.10 – «Физика полупроводников») перенесено на **9 октября 2020 года, 14:30 часов.**

## **Зиновьев Роман Александрович**

«Исследование дефектов в GaN светодиодах»

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Специальность **01.04.10** – «**Физика полупроводников**»

Работа выполнена на кафедре полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ «МИСиС»

**Научный руководитель:** к.т.н. Поляков Александр Яковлевич профессор, сотрудник кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников «НИТУ «МИСиС»

### **Экспертная комиссия:**

1. Ховайло Владимир Васильевич – д.ф.-м.н., доцент, в.н.с. кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ «МИСиС» - председатель комиссии;
2. Мурашев Виктор Николаевич – д.т.н., профессор, профессор кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ «МИСиС»;
3. Бублик Владимир Тимофеевич – д.ф.-м.н., профессор, профессор кафедры материаловедения полупроводников и диэлектриков НИТУ «МИСиС»;
4. Мармалюк Александр Анатольевич – д.т.н., начальник НТЦ АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»;
5. Редькин Аркадий Николаевич – д.ф.-м.н., заведующий экспериментально-технологической лаборатории Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук

### **Ведущее предприятие:**

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук г. Санкт-Петербург

Защита диссертации состоится «17» июня 2020 года по адресу 119049, г. Москва,

Ленинский проспект, д. 4